

单位: mil

LPVBG32F

产品特性:

尺寸

芯片尺寸: 18mil x 32mil
(432±25μm x 812±25μm)

芯片厚度: 5.3mil(135±10μm)

焊盘尺寸: 3.0mil(75±10μm)

焊盘金属

P焊盘: 金

N焊盘: 金



LatticePower

产品介绍

Product Introduction

LPVBG32F



LatticePower

产品介绍

Product Introduction

LPVBG32F

最大值

DC正向电流	30mA
正向峰值电流(1/10占空比@1kHz)	50mA
LED结温	115°C
反向电压	5V
使用温度范围	-40~85°C
贮存温度范围	0~40°C

说明:

- 1.最大额定值为晶能光电封装条件下测试得到,不同封装形式得到的值会有所不同,建议在不超过最大额定值的条件下使用,超过最大额定值使用可能会引起LED芯片损坏。
- 2.本产品非设计与逆向电流(压)下使用,不建议在任何逆向电流(压)下使用。

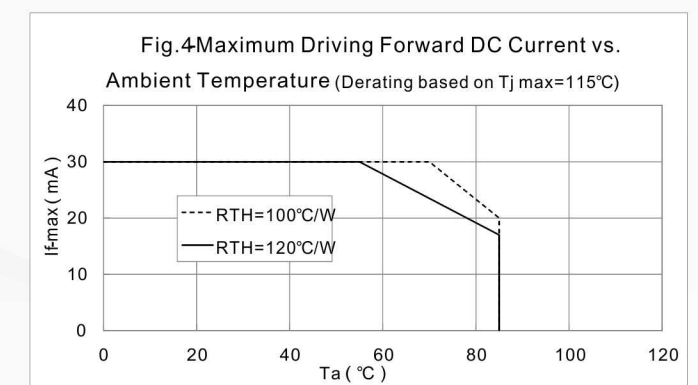
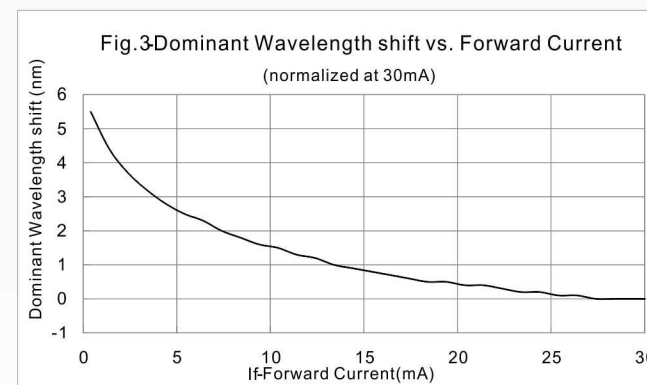
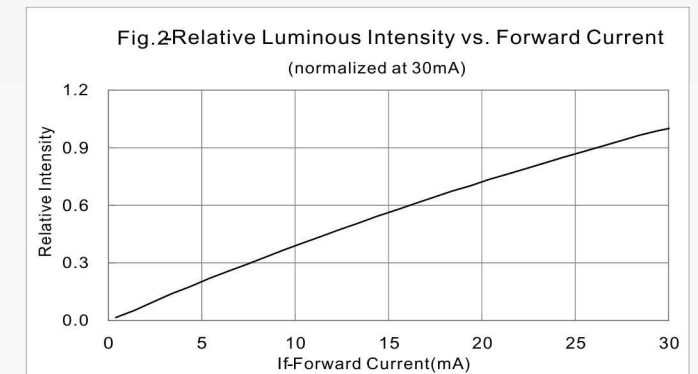
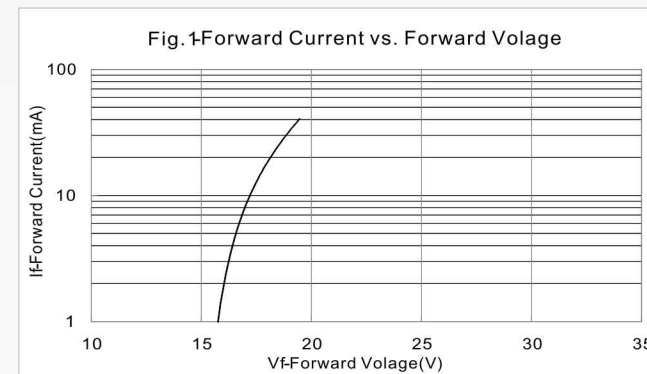
光电参数

参数	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
开启电压	V _{f1}	I _f =10μA	10	---	15	V
工作电压	V _{f2}	I _f =30mA	18	---	20	V
主波长	λ _d	I _f =30mA	445	---	475	nm
半波宽度	Δλ	I _f =30mA	---	---	30	nm
光功率	P _o	I _f =30mA	200	---	260	mW

参数等级

Po(mW)	Wd(nm)	447.5-450	450-452.5	452.5-455	455-457.5	457.5-460	460-462.5
250-260	FBTW	GATW	GBTW	HATW	HBTW	IATW	
240-250	FBSW	GASW	GBSW	HASW	HBSW	IASW	
230-240	FBRW	GARW	GBRW	HARW	HBRW	IARW	
220-230	FBQW	GAQW	GBQW	HAQW	HBQW	IAQW	
210-220	FBPW	GAPW	GBPW	HAPW	HBPW	IAPW	
200-210	FBOW	GAOW	GBOW	HAOW	HBOW	IAOW	

特性曲线



其它说明:

1. 光电参数为采用晶能光电测试仪器在室温下(T_A=25°C)测试结果;
2. GaN芯片为静电敏感产品,请在使用、运输时注意静电保护;
3. 可根据客户要求订做特殊规格芯片。

LatticePower

LatticePower